



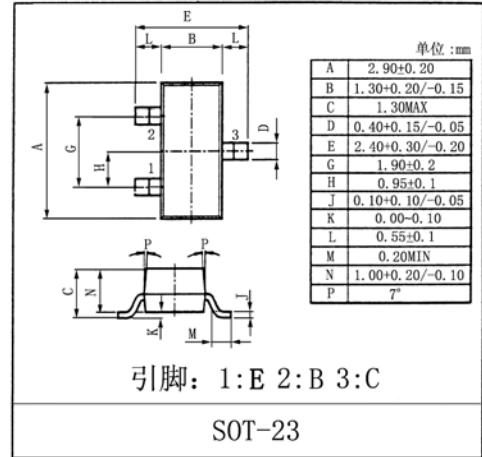
2SC1815M (3DG1815M)

硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途:用于普通低频放大,激励级放大。/Purpose: Audio frequency general purpose, driver stage amplifier applications.

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
$V_{CB0}$	60	V
$V_{CE0}$	50	V
$V_{EB0}$	5.0	V
$I_C$	150	mA
$I_B$	50	mA
$P_C$	300	mW
$T_j$	150	°C
$T_{stg}$	-55~150	°C



电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
$I_{CB0}$	$V_{CB}=60V$	$I_E=0$			0.1	$\mu A$
$I_{EB0}$	$V_{EB}=5.0V$	$I_C=0$			0.1	$\mu A$
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=6.0V$	$I_C=2.0mA$	70		700	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=6.0V$	$I_C=150mA$	25	100		
$V_{CE(sat)}$	$I_C=100mA$	$I_B=10mA$		0.1	0.25	V
$V_{BE(sat)}$	$I_C=100mA$	$I_B=10mA$			1.0	V
$f_T$	$V_{CE}=10V$	$I_C=1.0mA$	80			MHz
$C_{ob}$	$V_{CB}=10V$	$I_E=0$	$f=1.0MHz$	2.0	3.5	pF
$r_{bb}'$	$V_{CB}=10V$	$I_C=1.0mA$	$f=30MHz$	50		$\Omega$
NF	$V_{CE}=6.0V$ $R_g=10K\Omega$	$I_C=0.1mA$ $f=1.0KHz$		1.0	10	dB

$h_{FE(1)}$  分档/ $h_{FE(1)}$  classifications:

$h_{FE(1)}$ 分档 $h_{FE(1)}$ Classifications	0	Y	GR	BL
$h_{FE(1)}$ 范围 $h_{FE(1)}$ Range	70~140	120~240	200~400	350~700
印章 Marking	HHF0	HHFY	HHFG	HHFB

